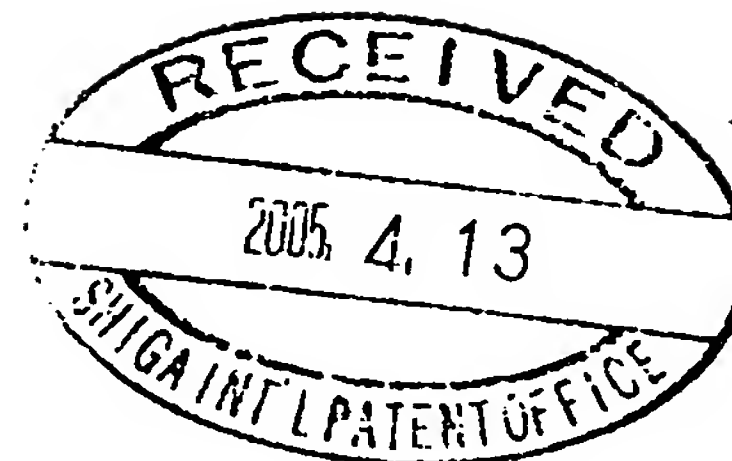


発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

特許協力条約



出願人代理人  
志賀 正武

あて名

様

〒 104-8453  
東京都中央区八重洲2丁目3番1号

PCT  
国際調査機関の見解書  
(法施行規則第40条の2)  
[PCT規則43の2.1]

発送日  
(日.月.年) 12.4.2005

出願人又は代理人  
の書類記号 PC-9419

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号  
PCT/JP2004/019596

国際出願日  
(日.月.年) 28.12.2004

優先日  
(日.月.年) 08.01.2004

国際特許分類 (IPC) Int. Cl. 'H01L27/12

出願人 (氏名又は名称)  
三菱住友シリコン株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎  
☐ 第II欄 優先権  
☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成  
☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如  
☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明  
☐ 第VI欄 ある種の引用文献  
☐ 第VII欄 国際出願の不備  
☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日  
28.03.2005

名称及びあて先  
日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)  
綿引 隆

4M 2934

電話番号 03-3581-1101 内線 3460

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

BEST AVAILABLE COPY

## 第1欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 書面

☐ コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる

☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

BEST AVAILABLE COPY

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)

請求の範囲

請求の範囲 1 - 4

有  
無

進歩性 (IS)

請求の範囲

請求の範囲 1 - 4

有  
無

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲

請求の範囲 1 - 4

有  
無

## 2. 文献及び説明

文献1 : JP 2003-224247 A(信越半導体株式会社)2003.08.08,  
段落【0031】～【0039】,図7(ファミリーなし)

文献2 : WO 2003/009386 A1(信越半導体株式会社)2003.01.30,  
比較例1,図1 & EP 1408551 A1 & US 2003/181001 A1

文献3 : WO 2003/009366 A1(S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES)2003.01.30,  
全文,全図 & EP 1407483 A1 & FR 2827423 A1 & US 2004/161948 A1

請求の範囲1～4に係る発明は、国際調査報告で引用した文献1に記載されているので新規性、進歩性を有しない。文献1の段落【0037】～【0039】には、剥離しSOIウエーハを形成した後、ダメージ層を除去するために犠牲酸化処理を行ない、その後、アルゴンなどの不活性ガス雰囲気中で熱処理することが記載されている。

請求の範囲1～4に係る発明は、国際調査報告で引用した文献1により進歩性を有しない。文献1には、剥離しSOIウエーハを形成した後、ダメージ層を除去するためにアルゴンガス雰囲気下での熱処理や、犠牲酸化処理を適宜組み合わせることが記載されている。よって、文献1に記載された発明において、ダメージ層を除去する手段として犠牲酸化処理を行った後、アルゴンガス雰囲気下で熱処理を行うことは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

請求の範囲1～4に係る発明は、国際調査報告で引用した文献2に記載されているので新規性、進歩性を有しない。文献2の比較例1には、剥離しSOIウエーハを形成した後、犠牲酸化処理、酸化膜除去を行なった後、Annealを行うことが記載されている。

請求の範囲1～4に係る発明は、国際調査報告で引用した文献3に記載されているので新規性、進歩性を有しない。文献3には、剥離しSOIウエーハを形成した後、犠牲酸化処理を行なった後、アルゴン雰囲気中でRTA処理を行うことが記載されている。

BEST AVAILABLE COPY